

## 1. 国内特許出願リスト

行番	特許公開番号	発明の名称
1	特開昭53-124039	不揮発性メモリ装置
2	特開昭58-086774	電界効果型トランジスタ
3	特開昭58-194368	半導体メモリ装置
4	特開昭59-014667	電界効果型トランジスタ
5	特開昭59-036393	不揮発性半導体メモリ装置
6	特開昭59-074680	半導体不揮発性メモリ装置およびその製造方法
7	特開昭59-098397	不揮発性半導体記憶装置
8	特開昭60-017917	電子ビーム露光方法
9	実開昭61-051745	セラミックパッケージ
10	特開昭61-099413	出力回路装置
11	特開昭61-112149	半導体集積回路露光用マスク
12	特開昭61-117795	半導体記憶装置
13	特開昭61-182214	半導体ウエハ
14	特開昭62-040699	半導体記憶装置
15	特開昭62-045059	半導体不揮発性記憶装置
16	特開昭62-038599	半導体記憶装置
17	特開昭62-045060	半導体不揮発性記憶装置
18	特開昭62-114200	半導体メモリ装置
19	特開昭62-114273	半導体記憶装置
20	特開昭62-162299	半導体不揮発性メモリデータの書込・読出方法
21	特開昭62-222499	不揮発性半導体記憶装置
22	特開昭62-238670	半導体記憶装置
23	特開昭62-206859	半導体装置
24	特開昭62-239500	半導体不揮発性メモリデータ書込み装置
25	特開昭62-241199	半導体記憶装置
26	特開昭63-007596	不揮発性半導体記憶装置用パッケージ
27	特開昭63-055799	半導体記憶装置
28	特開昭63-181192	半導体記憶装置
29	特開昭63-160098	紫外線消去形プログラマブル読出し専用記憶装置
30	特開昭63-181193	半導体記憶装置
31	特開昭63-147360	半導体記憶装置
32	特開昭63-276794	半導体記憶装置
33	特開昭63-253275	半導体装置
34	特開昭63-283072	可変しきい値型不揮発性半導体記憶装置の信頼性試験方法
35	特開昭63-258000	半導体記憶装置
36	特開昭63-273074	半導体記憶装置の信頼性試験方法
37	特開昭63-308388	半導体記憶装置
38	特開平01-023496	半導体記憶装置
39	特開平01-005040	EPROM用遮光シール
40	特開平01-035800	不揮発性半導体記憶装置
41	特開平01-041517	入力バッファ回路
42	特開平01-039700	半導体記憶装置
43	特開平01-067973	不揮発性半導体記憶装置
44	特開平01-094599	半導体記憶装置
45	特開平01-108777	不揮発性半導体記憶装置
46	特開平01-108778	半導体記憶装置
47	特開平01-123454	不揮発性半導体記憶装置
48	特開平01-128457	半導体装置
49	特開平01-105561	半導体不揮発性記憶装置
50	特開平01-137496	不揮発性半導体記憶装置
51	特開平01-161770	不揮発性半導体記憶装置
52	特開平01-117364	半導体不揮発性記憶装置
53	特開平01-296500	半導体記憶装置
54	実開平01-156567	半導体記憶装置
55	特開平02-003277	不揮発性半導体記憶装置
56	特開平02-002715	出力回路

57	特開平02-040198	不揮発性記憶装置
58	特開平02-118996	不揮発性メモリ装置
59	特開平02-161694	不揮発性半導体メモリ装置
60	特開平02-125521	半導体装置
61	特開平02-126500	誤り検出・訂正機能を備える半導体記憶装置
62	特開平02-143997	半導体集積回路装置
63	特開平02-141999	半導体記憶装置
64	特開平02-137196	不揮発性半導体記憶装置
65	特開平02-152100	半導体記憶装置
66	特開平02-183496	不揮発性半導体記憶装置
67	特開平02-156565	不揮発性半導体記憶装置
68	特開平02-270200	半導体メモリ装置
69	特開平02-232899	不揮発性半導体メモリ装置
70	特開平03-162800	半導体メモリ装置

## 2. 海外特許出願リスト

	Publication number	Title	Publication date
1	US4779272 (A)	Testable variable-threshold non-volatile semiconductor memory	1988/10/18
2	US5195099 (A)	Semiconductor memory device having improved error correcting circuit	1993/3/16
3	US4827452 (A)	Semiconductor memory including a selectively disabled redundancy circuit	1989/5/2
4	US5262342 (A)	Method of making a semiconductor memory device having error checking/correcting functions	1993/11/16
5	US5182725 (A)	Nonvolatile semiconductor memory device with reduced variation in source potential of floating gate type memory transistor and operating method therefor	1993/1/26
6	US5058071 (A)	Semiconductor memory device having means for repairing the memory device with respect to possible defective memory	1991/10/15
7	US5097152 (A)	BUFFER CIRCUIT USED IN A SEMICONDUCTOR DEVICE OPERATING BY DIFFERENT SUPPLY POTENTIALS AND METHOD OF OPERATING THE SAME	1992/3/17
8	US5172339 (A)	SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE HAVING ERROR CHECKING AND CORRECTING CIRCUIT AND OPERATING METHOD THEREFOR	1992/12/15
9	US5105386 (A)	Nonvolatile semiconductor memory device with reduced variation in source potential of floating gate type memory transistors and operating method therefor	1992/4/14
10	US4651186 (A)	Field effect transistor with improved withstand voltage characteristic	1987/3/17
11	US5262984 (A)	Non-volatile memory device capable of storing multi-state data	1993/11/16
12	US5021999 (A)	Non-volatile semiconductor memory device with facility of storing tri-level data	1991/6/4
13	US5107313 (A)	FLOATING GATE TYPE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE	1992/4/21
14	US4949305 (A)	Erasable read-only semiconductor memory device	1990/8/14
15	US4958352 (A)	Semiconductor memory device with error check and correcting function	1990/9/18
16	DE4000219 (A1)	Semiconductor memory with externally applied programming voltage - has programming voltage detector determining its level w.r.t. preset one	1990/7/12
17	DE3936704 (A1)	Error-detecting cellular semiconductor memory with codeword generator - includes writing and read-out circuits for test data and stored codewords, integrated on same memory chip	1990/5/10
18	DE3833717 (A1)	Semiconductor component	1989/6/1
19	DE3537055 (A1)	Output circuit with enhancement IGFETs - uses two IGFETs with different threshold voltages achieved on different amounts or strengths of ion implantation	1986/4/30
20	DE3316675 (A1)	Semiconductor memory device	1983/11/10